

SiC ウエハー



次世代パワーデバイス材料、 短時間・低コストで究極の面粗さとTTVを実現

TDC独自のSiC ウエハー研磨技術とは

東北大学多元物質科学研究所との共同研究により、SiC(炭化ケイ素)の面粗さ・TTVの高精度化を効率的に実現する革新的研磨技術を確立しました。

独自のSiCウエハー研磨技術が選ばれる理由

SiCは大変優れた材料特性から次世代パワーデバイス材料として有望視されていますが、高硬度で安定な材質であるがゆえに研磨プロセスのコストが障壁となっていました。

そこでTDCでは東北大学多元物質科学研究所との共同研究、産業技術総合研究所のご指導の下、自社独自の研磨技術を開発し、短時間・低コストで究極のウエハー品質(粗さ・TTV)を実現することに成功しました。

仕様

詳しくはお問い合わせください。

●1個から量産品まで対応 ●材料調達から全加工まで対応 ●納期、価格、その他詳細についてはお問い合わせください

お問い合わせ先

